

ИНДУЦИРОВАННОЕ ПРОДОЛЬНЫМ МАГНИТНЫМ ПОЛЕМ ПОНИЖЕНИЕ ОПТИЧЕСКОГО КЛАССА АНТИФЕРРОМАГНИТНОГО КРИСТАЛЛА

Н.Ф.Харченко, В.В.Еременко, Л.И.Белый

Экспериментально наблюдалось в двухподрешеточном коллинеарном тетрагональном антиферромагнетике индуцирование продольным магнитным полем линейного по напряженности поля двупреломления линейно поляризованного света, распространяющегося вдоль тетрагональной оси. Величина двупреломления позволяет визуально различать в магнитном поле антиферромагнитные состояния, отличающиеся направлением антиферромагнитного вектора. Показано, что искажения в поле тетрагональной структуры не являются определяющими для наблюдаемого магнитооптического эффекта.

Наличие магнитной подсистемы в магнитоупорядоченных кристаллах может при определенных обстоятельствах приводить к несколькис

необычным оптическим свойствам кристаллов высших кристаллографических и магнитных сингоний. Например, тетрагональные кристаллы, в магнитной точечной группе которых операция поворота на угол $\pi/2$ является операцией симметрии только в комбинации с операцией инверсии времени R , неизбежно должны понижать свой оптический класс в магнитном поле H , направленном вдоль оси C_4 и не нарушающем коллинеарного расположения магнитных моментов ионов [1]. Рассматриваемый магнитооптический эффект линеен по H_z и родственен обратному пьезомагнитному эффекту в одноосных кристаллах.

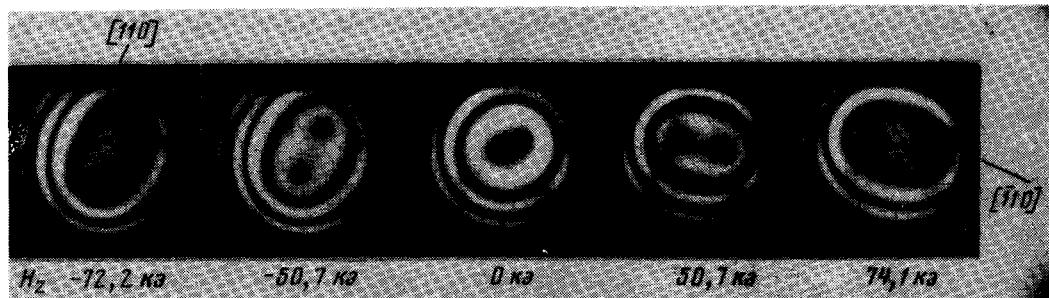


Рис.1. Изменение коноскопических фигур коллинеарного антиферромагнетика CoF_2 в зависимости от направления и величины поля $H \parallel C_4 \parallel Z$. Образец находится в однодоменном антиферромагнитном состоянии $l_z^+, \lambda \approx 4000 \text{ \AA}$, $T \approx 30 \text{ K}$

В настоящей работе сообщается об обнаружении линейного по напряженности магнитного поля двупреломления линейно поляризованного света, распространяющегося вдоль кристаллографической оси тетрагонального коллинеарного антиферромагнетика CoF_2 . Измерение двупреломления (L_D) проводилось в импульсных магнитных полях с помощью коноскопического метода при циркулярной поляризации света. Напряжения, обусловленные креплением образца, приводили к небольшой деформации оптической индикатрисы такой, что плоскость оптических осей была близка к плоскости (100) (рис. 1). Эти напряжения способствовали образованию определенной однодоменной антиферромагнитной структуры. Включение магнитного поля $H \parallel C_4$ вызывает отчетливо фиксируемое увеличение угла между оптическими осями и разворот плоскости расположения осей. Направление разворота зависит от направления H и предыстории образца, определяющей направление антиферромагнитного вектора в кристалле. Рис. 1 демонстрирует изменение индикатрисы однодоменного антиферромагнитного (АФМ) кристалла в зависимости от направления и величины магнитного поля. Зависимость величины $(\tilde{n}_g - \tilde{n}_m)$, определенной из коноскопических фигур, от напряженности поля близка к линейной в поле, большем 15 кэ, а разность между азимутами плоскостей расположения осей при противоположных направлениях поля стремится с ростом поля к 90° .

Индукцируемое полем ЛД удобно описать зависимостью компонент тензора диэлектрической непроницаемости от ориентации и величины магнитных векторов, описывающих магнитную структуру кристалла.

Для кристалла CoF_2 с разбиением магнитных ионов на подрешетки типа $4_z^- 2_d^+$ можно записать:

$$\begin{aligned}\delta \epsilon_{xx}^{-1} &= \Delta_{xxxx} m_x l_y + \Delta_{xxyx} m_y l_x, \\ \delta \epsilon_{yy}^{-1} &= \Delta_{xxxx} m_y l_x + \Delta_{xxyx} m_x l_y, \\ \delta \epsilon_{zz}^{-1} &= \Delta_{zzxy} (m_x l_y + m_y l_x), \\ \epsilon_{yz}^{-1} &= \Delta_{yzzz} m_x l_z + \Delta_{yzzx} m_z l_x, \\ \epsilon_{xz}^{-1} &= \Delta_{yzzz} m_y l_z + \Delta_{yzzx} m_z l_y, \\ \epsilon_{xy}^{-1} &= \Delta_{xyxx} (m_x l_x + m_y l_y) + \Delta_{xyzz} m_z l_z.\end{aligned}\tag{1}$$

В продольных полях $H < 10^5$ э магнитная структура CoF_2 остается коллинеарной, поперечные компоненты m_x , m_y , l_x , l_y равны нулю и разность главных показателей преломления в свободном от механических напряжений кристалле равна:

$$n_g - n_m = 2 n_o^3 \Delta_{xyzz} M_o \chi_{zz} H. \tag{2}$$

Азимут расположения оптических осей относительно оси X равен $\phi = \pi/4 \operatorname{sign} H_z \operatorname{sign} l_z$. С учетом наблюдаемой исходной деформации индикатрисы он отличается от 45° , а разность показателей преломления равна:

$$n_{x'x'} - n_{y'y'} = (\tilde{n}_g - \tilde{n}_m) \sin 2\phi = 2 n_o^3 \Delta_{xyzz} M_o \chi_{zz} H \operatorname{sign} l_z \operatorname{sign} H_z, \tag{3}$$

где $(\tilde{n}_g - \tilde{n}_m)$ и $\tilde{\phi}$ – измеряемые величины, оси X' и Y' параллельны осям [110] и [110] в отличие от $X \parallel [100]$ и $Y \parallel [010]$.

На рис. 2 приведена полученная зависимость ЛД $\Delta n_{x'y'} = n_{x'x'} - n_{y'y'}$ от напряженности поля. Две прямые соответствуют двум однодоменным состояниям образца с противоположными направлениями АФМ вектора \mathbf{l} . В зависимости от направления и величины поля устойчивым может оказаться то или другое направление вектора \mathbf{l} . Однодоменное состояние образца остается и после выключения поля. Перемагничивание магнитных подрешеток, при котором направление \mathbf{l} сохраняется, а энергетически невыгодное направление \mathbf{l} изменяется на противоположное, происходит путем образования доменной структуры двух АФМ состояний l_z^+ и l_z^- . На рис. 3 процесс перемагничивания проиллюстрирован коноскопическими фигурами. Рис. 3 соответствует неоднородному состоянию образца с несколькими крупными АФМ доменами.

Из зависимости $\Delta n_x \sim H$ (рис. 2) можно определить коэффициент Δ_{xyzz} , который при $T = 11\text{K}$ для $\lambda \approx 4000\text{\AA}$ оказался равным $1,3 \times 10^{-12}$ (ед CGSM/моль)². Необходимые значения $\chi_{zz} = 1,3 \cdot 10^{-2}$ ед CGSM/моль, и $2M_0 = 16750$ ед CGSM/моль взяты из работ [2, 3], показатель преломления взят равным 1,5 [4].

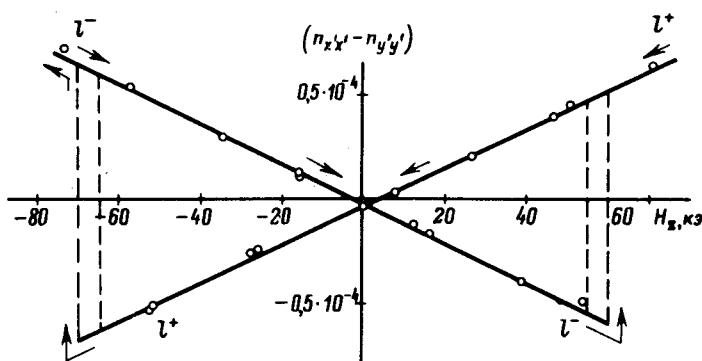


Рис.2. Зависимость индуцируемого магнитным полем $H \parallel C_4 \parallel Z$ двупреломления для света, распространяющегося вдоль оси C_4 , от направления и величины поля. Две прямые соответствуют двум антиферромагнитным состояниям образца; $\lambda \approx 4000\text{\AA}$, $T \approx 11\text{K}$

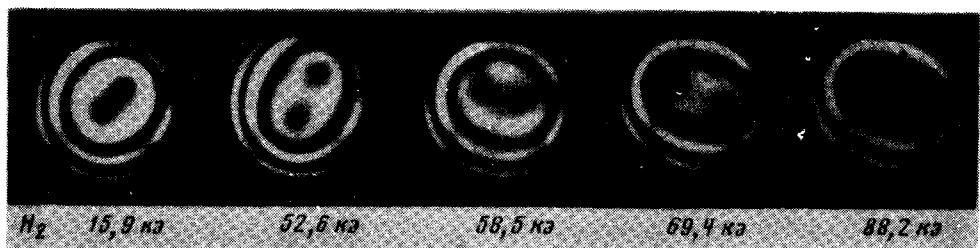


Рис.3. Изменение коноскопических фигур в процессе перемагничивания антиферромагнитного состояния образца. Исходное антиферромагнитное состояние l_z^- энергетически не выгодно в поле $H_z > 60\text{ кэ}$

Вклад в величину магнитооптического коэффициента, ответственно за линейное по полю ЛД, могут дать различные механизмы. Появление $\epsilon_{xy} \neq 0$ обусловлено различной поляризуемостью неэквивалентных

ионов Co^{++} , совместно с их лигандным окружением, в магнитном поле в результате (1) неэквивалентного квантовомеханического перемешивания состояний в магнитном поле при совместном влиянии низкосимметричного кристаллического поля и спин-орбитального взаимодействия, (2) различной заселенностью низкосимметричных возбужденных состояний в неэквивалентных ионах, (3) различных сдвигов энергетических уровней ионов первой и второй подрешеток. Кроме того, заметный вклад в ϵ_{xy} может дать вторичный фотоупругий эффект, возникающий из-за магнитострикции при обратном пьезомагнитном эффекте. Чтобы определить вторичное ЛД был измерен пьезооптический эффект в CoF_2 . Направление сжатия образца совпадало с направлением [110], температура равнялась 20,4К. Фотоупругий коэффициент π_{66} оказался близким к $0,6 \cdot 10^{-13} \text{ см}^2/\text{дин}$. Зная магнитострикционные деформации вдоль [110] $|\Delta l/l|_{xy} = 4,9 \cdot 10^{-10} H$ [5] и упругую константу $C_{66} = 8,5 \cdot 10^{11} \text{ дин}/\text{см}^2$ [4], находим вклад в ЛД, обусловленный линейной магнитострикцией в поле $H \parallel Z$:

$$|\Delta n_{x'y'}|_{\Phi Y} = 4,9 \cdot 10^{-10} n_0^3 \pi_{66} C_{66} H,$$

где H в эрстедах. При $H = 5 \cdot 10^4$ э $|\Delta n_{x'y'}|_{\Phi Y} = 0,4 \cdot 10^{-5}$, на порядок меньше наблюдаемой величины $0,5 \cdot 10^{-4}$. Следовательно, искажения тетрагональной структуры не являются определяющими для наблюдаемого магнитооптического эффекта.

Физико-технический институт
низких температур
Академии наук Украинской ССР

Поступила в редакцию
10 июля 1978 г.

Литература

- [1] В.С.Островский, В.М.Локтев. Письма в ЖЭТФ, 26, 139, 1977.
- [2] А.С.Боровик-Романов. ЖЭТФ, 38, 1088, 1960.
- [3] В.И.Ожогин. ЖЭТФ, 45, 1687, 1963.
- [4] Yu. A. Popkov. V.I.Fomin. Proceeding of the Second Intern. Conf. of Light Scattering in Solids, Paris 1971, p. 503.
- [5] А.С.Прохоров, Е.Г.Рудашевский. Письма в ЖЭТФ, 10, 175, 1969.